

大見研究室 和文 論文リスト

1989 年

- 126-1(P) 水口泰光、大見忠弘、杉山和彦、菅野洋一、溝上敏、宮北勲、鶴羽正敏、浜田汎史、「超高純度ガス供給系用溶接技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.1-25、1989年1月。
- 127-1(P) 内沢修、畑山忠弘、菅野洋一、大見忠弘、「半導体ガスプロセス用バルブの高性能化—オールメタルダイヤフラムバルブ—」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.27-48、1989年1月。
- 128-1(P) 中原文生、大見忠弘、杉山和彦、水口泰光、Henry Berger、中村雅一、三平博、佐藤清志、「高純度ガス希釈器とそのAPIMSによる評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.49-78、1989年1月。
- 129-1(P) 徳永重則、都田昌之、菅野洋一、大見忠弘、「開放系装置における大気の逆拡散」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.79-98、1989年1月。
- 130-1(P) 奥村毅、大見忠弘、杉山和彦、仲原善行、林茂樹、阪中隆、太田栄治、高石一英、浜田汎史、泊里治夫、佐藤文博、那須進、津田格、「金属表面不動態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.99-117、1989年1月。
- 131-1(P) 前野又五郎、丸橋一夫、中川佳紀、三木正博、大見忠弘、「金属表面フッ化不動態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.119-139、1989年1月。
- 132-1(P) 森田瑞穂、大見忠弘、長谷川英司、河上道也、須磨克博、「Si表面自然酸化膜形成過程」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.169-193、1989年1月。
- 133-1(P) 菊山裕久、三木正博、宮下雅之、川辺一郎、森田瑞穂、大見忠弘、「自然酸化膜選択除去技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.195-222、1989年1月。
- 134-1(P) 稲葉仁、竹浪敏人、大見忠弘、山崎俊彦、「風速、気流分布及びダスト飛散の評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.8、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.245-290、1989年1月。
- 134-2(M) 大見忠弘、柴田直、「低エネルギーイオン照射を用いた低温薄膜形成技術」、機能性薄膜の形成技術の開発と応用、昭和63年度科学研究費補助金〈総合研究(A)〉、研究成果報告書、(研究代表者名古屋大学工学部 安田幸夫)、pp.119-123、1989年1月。
- 135(P) 桑原英司、斉藤悟、斉藤達之、小谷光司、柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射プロセスを用いたメタライゼーション技術」、電気学会研究会資料、(電子デバイス研究会)、論文番号 EDD-89-31、pp.1-10、1989年2月。
- 136(F) 大見忠弘、「超クリーンシステムの科学」、応用物理第58巻第2号、((社)応用物理学会)、pp.193-211、1989年2月。
- 137-1(M) 大見忠弘、「超微細加工を支える環境技術—スーパークリーンルーム—」、21世紀へのフロンティア” 極限技術への挑戦”、日本機械学会編(三田出版会)pp.67-120、1989年2月。

- 49-2(B) 矢部江一、石川浩朗、水庭哲夫、田中和光、大見忠弘、「精密抵抗率測定」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅱーウエットプロセス技術ー、(リアライズ社)、pp.11-21、1989年2月。
- 51-1(B) 大見忠弘、三島博之、水庭哲夫、阿部光夫、「ウェハ表面吸着分子分析」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅱーウエットプロセス技術ー、(リアライズ社)、pp.93-107、1989年2月。
- 52-2(B) 安井富春、水庭哲夫、三島博之、阿部光夫、大見忠弘、「パーティクルフリー洗浄・乾燥技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅱーウエットプロセス技術ー、(リアライズ社)、pp.135-163、1989年2月。
- 137-2(C) 大見忠弘、「サブミクロンULSI製造技術」、第3回ISSジャパン、半導体デバイス・製造装置／材料の市場予測セミナー、テキスト、(SEMIジャパン)、pp.KEYNOTE1-KEYNOTE5、1989年2月。
- 138(B) 大見忠弘、御子柴宣夫、「超微細加工における環境技術」、機械の研究第41巻第3号、(株養賢堂)、pp.25-34、1989年3月。
- 139(C) 大見忠弘、「pptへ挑戦する超クリーン化技術の構築」、ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム'89、テキスト、((社)日本能率協会)、pp.(1-1-1)-(1-1-8)、1988年3月。
- 140(C) 杉山和彦、大見忠弘、「ガス供給系の超クリーン化と膜分離技術」、ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム'89、テキスト、((社)日本能率協会)、pp.(1-2-1)-(1-2-10)、1989年3月。
- 141(C) 河上道也、大見忠弘、岡崎素弘、「超純水系の超クリーン化と膜分離技術」、ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム'89、テキスト、((社)日本能率協会)、pp.(1-3-1)-(1-3-8)、1989年3月。
- 36-2(B) 大見忠弘、室田淳一、三井泰裕、杉山和彦、川崎健弘、河野博明、大森宣典、松坂一紀、「ガス純化技術ーH₂、Ar、He、N₂、及び、フィルタ内臓純化装置ー」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.7-30、1989年3月。
- 37-2(B) 三井泰裕、大見忠弘、室田淳一、杉山和彦、川崎健弘、河野博明、大森宣典、松坂一紀、「超高純度ガス評価技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.31-56、1989年3月。
- 38-2(B) 黒宮茂、光地哲伸、大見忠弘、「ガス供給系の高純度化」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.57-86、1989年3月。
- 39-2(B) 都田昌之、菅野洋一、大見忠弘、「配管系ガス置換特性」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.87-101、1989年3月。
- 72-2(B) 大見忠弘、室田淳一、「クリーンボンベとガス充填技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.135-152、1989年3月。
- 74-2(B) 阿部光夫、杉山和彦、大見忠弘、宮野安定、箭原繁雄、「パラジウム膜水素純化装置」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.189-213、1989年3月。
- 78-2(B) 杉山和彦、中原文生、奥村毅、大見忠弘、室田淳一、「アウトガスフリー耐腐食性ステンレス表面処理技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.215-224、1989年3月。
- 73-2(B) 菅野洋一、都田昌之、徳永重則、大見忠弘、「高速置換特性を有するガス配管系と、流体の流れに逆らう拡散について」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅰーガス供給システムー、(リアライズ社)、pp.153-188、1989年3月。

- 75-2(B) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーが可能にする新しいプロセス技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.13-24、1989年3月。
- 41-2(B) 柴田直、桑原英司、大見忠弘、斉藤達之、清田哲司、「DC-RF結合バイアススパッタ技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.27-41、1989年3月。
- 42-2(B) 大見忠弘、菅野洋一、畑山忠弘、森川栄久、須磨克博、森田瑞穂、「薄い酸化膜生成技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.43-60、1989年3月。
- 43-2(B) 黒宮茂、吉武春二、岩淵浩志、佐藤源一、大見忠弘、「超高純度エピタキシャル成長技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.61-76、1989年3月。
- 76-2(B) 室田淳一、中村直人、加藤学、御子柴宣夫、大見忠弘、「高選択性を有するウルトラクリーンCVD技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.77-86、1989年3月。
- 77-2(B) 森田瑞穂、光地哲伸、大見忠弘、熊谷浩洋、伊藤雅樹、「自由分子流照射型低温高速CVD技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.87-96、1989年3月。
- 70-2(B) 大見忠弘、竹浪敏人、室田淳一、御子柴宣夫、坪内和夫、益一哉、「スーパークリーンルームの省エネルギー設計と省エネルギー運転」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.133-162、1989年3月。
- 50-2(B) 藤崎芳男、平塚豊、大見忠弘、「省電力形クリーンドラフト」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.163-181、1989年3月。
- 71-2(B) 安田正志、竹浪敏人、大見忠弘、「微振動計測と振動対策」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、LSI製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ－ULSIプロセス技術－、(リアライズ社)、pp.183-213、1989年3月。
- 142(M) 大見忠弘、「ppt へ挑戦する超クリーン化技術の構築」、STEP/Ultra Clean、STEP資料、(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS INTERNATIONAL, JAPAN) 1989年4月。
- 143(M) 菊山裕久、高野順、三木正博、大見忠弘、「フッ化水素酸の清浄化技術」、STEP/Ultra Clean、STEP資料、(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS INTERNATIONAL, JAPAN) 1989年4月。
- 144(M) 杉山和彦、大見忠弘、「ガス供給系の超クリーン化」、STEP/Ultra Clean、STEP資料、(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS INTERNATIONAL, JAPAN) 1989年4月。
- 145(M) 河上道也、大見忠弘、「超純水系の超クリーン化」、STEP/Ultra Clean、STEP資料、(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS INTERNATIONAL, JAPAN) 1989年4月。
- 146(M) 稲葉仁、大見忠弘、竹浪敏人、「クリーンルームの現状と将来の展望」、STEP/Ultra Clean、STEP資料、(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS INTERNATIONAL, JAPAN) 1989年4月。
- 147(M) 水口泰光、杉山和彦、中原文生、大見忠弘、「オールメタル製精密希釈器による半導体材料ガス供給技術」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料デバイス研究会)、論文番号 SDM89-2、pp.7-12、1989年4月。
- 148(M) 河上道也、大見忠弘、「ウェハの超純水洗浄および乾燥工程の超クリーン化」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM89-4、pp.19-22、1989年4月。

- 149-1(M) 宮下雅之、川辺一郎、大見忠弘、菊山裕久、三木正博、「無水フッ化水素ガスによる自然酸化膜の選択除去」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM89-7、pp.33-38、1989年4月。
- 149-2(M) 森田瑞穂、大見忠弘、「自然酸化膜を科学する」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.1、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.22-28、1989年4月。
- 150(M) 大見忠弘、今井茂、橋本尚、「超高速LSI用デバイス・配線構造」、電子情報通信学会論文誌、VOL.J72-C-II No.5、(社)電子情報通信学会)、pp.542-547、1989年5月。
- 151(M) 大見忠弘、石原良夫、柴田直、沖田彰、「高濃度イオン注入層の低温アニール技術」、電子情報通信学会論文誌、VOL.J72-C-II No.5、(社)電子情報通信学会)、pp.571-576、1989年5月。
- 152(C) 杉山和彦、大見忠弘、水口泰光、「サブミクロンULSI製造用ガス供給技術」第7回大阪酸素-半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業㈱)、pp.63-80、1989年6月。
- 153(C) Tadahiro Ohmi、「Future Trends in Ultra Clean Technology」、第7回大阪酸素-半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業㈱)、pp.81-90、1989年6月。
- 154(C) 柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射を用いた表面クリーニングと低温高品質薄膜形成技術」、セミコン大阪技術セミナー '89講演予稿集、(SEMI)、pp.63-75、1989年6月。
- 155(C) 菊山裕久、三木正博、宮下雅之、川辺一郎、大見忠弘、「自然酸化膜の選択ドライエッチング」、セミコン大阪技術セミナー '89講演予稿集、(SEMI)、pp.129-144、1989年6月。
- 156(M) 坪内和夫、益一哉、田中正則、大見忠弘、御子柴宣夫、林茂樹、丸井隆雄、寺本晃、梶川鉄夫、副島啓義、「 μ -RHEED装置の開発」、島津科学計測ジャーナル 6月号第1巻 第2号 通巻224号、(㈱島津製作所 計測事業本部)、pp.50-52、1989年、6月。
- 157-1(P) 大見忠弘、竹浪敏人、稲葉仁、「トータルクリーンシステム-スーパークリーンルームの空調除塵システム-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.9、クリーンルーム及びその付帯設備、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-32、1989年6月29日~7月1日。
- 158-1(P) 竹浪敏人、稲葉仁、大見忠弘、「冷却水システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.9、クリーンルーム及びその付帯設備、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.55-79、1989年6月29日~7月1日。
- 159-1(P) 稲葉仁、竹浪敏人、大見忠弘、「磁場変動対策」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.9、クリーンルーム及びその付帯設備、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.139-164、1989年6月29日~7月1日。
- 160-1(P) 稲葉仁、大見忠弘、「静電気の影響」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.9、クリーンルーム及びその付帯設備、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.207-238、1989年6月29日~7月1日。
- 161-1(P) 菊山裕久、坂喜代憲、高野順、三木正博、大見忠弘、「化学薬品用容器」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.9、クリーンルーム及びその付帯設備、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.307-322、1989年6月29日~7月1日。
- 162 (M) 森田瑞穂、長谷川英司、河上道也、大見忠弘、「Si自然酸化膜形成の制御」、電子情報通信学会技術研究報告、(社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-39、pp.11-12、1989年6月。
- 163(P) 桑原英司、斎藤悟、小谷光司、柴田直、大見忠弘、「ウルトラクリーン雰囲気中で形成した低バイアススパッタAl膜の性質」、ECS日本支部第2回シンポジウム、プロシーディング、ULSIにおけるAl配線技術の関する諸問題(ECS日本支部)、pp.61-66、1989年7月。
- 164(M) 杉山和彦、大見忠弘、「不動態処理」酸化膜」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.1、No.2(半導体基盤技術研究会)、pp.7-11、1989年7月。
- 165(M) 三木正博、前野又五郎、丸橋一夫、中川佳紀、大見忠弘、「完全に制御された金属表面を目指して-金属表面フッ化不動態化技術-」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.1、No.2(半導体基盤技術研究会)、pp.12-18、1989年7月。

- 166(M) 松浦孝、植竹宏明、室田淳一、福田航一、大見忠弘、御子柴宣夫、川島忠、山下義弘、「ECRプラズマによる完全選択異方性エッチング」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.173、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-74、pp7-12、1989年 8月。
- 167(M) 沖田彰、石原良夫、柴田直、大見忠弘、新田雄久、杉浦順、大和田伸郎、「UHVイオン注入装置を用いて形成したPN接合の低温アニール特性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.173、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-76、pp19-22、1989年 8月。
- 168(M) 森田信、橋本圭一、柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射による 250°Cのシリコンエピタキシャル成長」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.174、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-83、pp13-18、1989年 8月。
- 169(M) 大月正人、斎藤達之、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「低エネルギーイオン照射プロセスにより形成したCu薄膜の熱安定性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.174、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-84、pp19-23、1989年 8月。
- 170(M) 三木正博、大見忠弘、「超高純度フッ化水素の精製と超LSI技術への応用」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.89 No.174、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM89-86、pp31-38、1989年 8月。
- 171(C) 大見忠弘、稲葉仁、「先端技術が要求する環境雰囲気制御」、日本機械学会・精密工学会東北支部盛岡地方講演会講演概要集、(日本機械学会東北支部、精密工学会東北支部)、pp.170-171、1989年、8月。
- 172(M) 大見忠弘、稲葉仁、「環境制御技術」、日経マイクロデバイス 1989年 9月号、No.51、(日経BP社)、pp.115-136、1989年 9月。
- 173(P) 大見忠弘、森田瑞穂、「総論:ナノメータ絶縁膜—その展望と課題—」、1989年電子情報通信学会秋季全国大会、講演論文集、((社)電子情報通信学会)、pp.5-183~5-184、1989年 9月。
- 174(P) 森田瑞穂、長谷川英司、大見忠弘、「ナノメータ絶縁膜のための製造プロセス環境—良い極薄絶縁膜を作るには—」、1989年電子情報通信学会秋季全国大会、講演論文集、((社)電子情報通信学会)、pp.5-193~5-194、1989年 9月。
- 175-1(M) 田中信義、橋本誠二、篠原真人、須川成利、森下正和、松本繁幸、中村佳夫、大見忠弘、「31万画素バイポーライメージセンサ(BASIS)」、電子情報通信学会技術研究報告[集積回路]、((社)電子情報通信学会)、論文番号 ICD89-122、pp.79-86、1989年 9月。
- 175-2(C) 泊里治夫、寺田誠、那須進、大見忠弘、杉山和彦、仲原喜行、「半導体製造ガス供給システム用高性能クリーンパイプの開発」、神戸製鋼技報、Vol.39 No.4 (株神戸製鋼所)、pp.57-60、1989年 10月。
- 175-3(C) 大見忠弘、「研究開発に於ける国際協力の必然性」、半導体国際交流シンポジウム '89報告書、半導体の国際産業協力のあり方を求めて、pp.53-59、1989年 10月。
- 176-1(P) 小谷光司、大見忠弘、「RIE用ガス排気システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp. I -5-1~ I -5-24、1989年 11月。
- 177(P) 大見忠弘、「高性能ULSI装置(ディープサブミクロンULSI製造装置に関する提案)」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.III-1-1~III-1-26、1989年 11月。
- 178(P) 森田瑞穂、大見忠弘、長谷川英司、寺本章伸、川尻進、「極薄ゲート酸化膜形成装置」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.III-2-1~III-2-21、1989年 11月。
- 179-1(P) 杉山和彦、大見忠弘、水口泰光、中村雅一、「半導体工場用トータルガスシステムの設計概念」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.IV-1-1~IV-1-30、1989年 11月。

- 180-1(P) 加藤芳久、仲内宏、大見忠弘、「ウルトラクリーンボンベ設置、クリーニング、ガスの充填方法」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.IV-2-1～IV-2-18、1989年11月。
- 181-1(P) 水口泰光、大見忠弘、杉山和彦、中村雅一、「酸化パッシベーション施したプラスチック材料フリー、オールメタル製ガス供給システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.10、サブミクロンULSI製造技術、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.IV-3-1～IV-3-21、1989年11月。
- 93-2(B) 竹浪敏人、大見忠弘、福田宗治、「省エネルギー型空調除塵システム」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.13-35、1989年11月。
- 94-2(B) 水庭哲夫、矢部江一、後藤幸雄、大見忠弘、「超純水システム」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.37-51、1989年11月。
- 95-2(B) 中原文生、杉山和彦、佐藤剛士、大見忠弘、「プロセス用ガス配管システムの設計論」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.53-77、1989年11月。
- 96-2(B) 柄崎英夫、菅田佳寿、東川智信、大見忠弘、杉山和彦、「無発塵空圧計装システム」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.97-132、1989年11月。
- 100-2(B) 大見忠弘、「プロセス完全自動化への方向」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.157-180、1989年11月。
- 97-2(B) 宮下雅之、川辺一郎、丸橋一夫、石田隆史、菊山裕久、前野又五郎、三木正博、室田淳一、大見忠弘、「ウェハドライ洗浄 フッ化不動態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.183-212、1989年11月。
- 98-2(B) 柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射成膜技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.223-232、1989年11月。
- 99-2(B) 今井茂、石原良夫、丁剛珠、大見忠弘、「自己整合加熱によるプロセスの低温化」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 I、(リアライズ社)、pp.233-250、1989年11月。
- 126-2(B) 水口泰光、大見忠弘、杉山和彦、菅野洋一、溝上敏、宮北勲、鶴羽正敏、浜田汎史、「超高純度ガス供給系用溶接技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.17-30、1989年11月。
- 127-2(B) 内沢修、畑山忠弘、菅野洋一、大見忠弘、「半導体ガスプロセス用バルブの高性能化—オールメタルダイヤフラムバルブ—」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.31-57、1989年11月。
- 128-2(B) 中原文生、大見忠弘、杉山和彦、水口泰光、Henry Berger、中村雅一、三平博、佐藤清志、「高純度ガス希釈器とそのAPIMSによる評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.61-81、1989年11月。
- 129-2(B) 徳永重則、都田昌之、菅野洋一、大見忠弘、「開放系装置における大気の逆拡散」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.83-106、1989年11月。
- 130-2(B) 奥村毅、大見忠弘、杉山和彦、仲原善行、林茂樹、阪中隆、太田栄治、高石一英、浜田汎史、泊里治夫、佐藤文博、那須進、津田格、「金属表面不動態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.109-119、1989年11月。
- 131-2(B) 前野又五郎、丸橋一夫、中川佳紀、三木正博、大見忠弘、「金属表面フッ化不動態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術 II、(リアライズ社)、pp.121-135、1989年11月。

- 132-2(B) 森田瑞穂、大見忠弘、長谷川英司、河上道也、須磨克博、「Si表面自然酸化膜形成過程」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、(リアライズ社)、pp.175-195、1989年11月。
- 133-2(B) 菊山裕久、三木正博、宮下雅之、川辺一郎、森田瑞穂、大見忠弘、「自然酸化膜選択除去技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、(リアライズ社)、pp.197-216、1989年11月。
- 134-3(B) 稲葉仁、竹浪敏人、大見忠弘、山崎俊彦、「風速、気流分布及びダスト飛散の評価【ウェハへの帯電粒子の付着】」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、サブミクロンULSIプロセス技術Ⅱ、(リアライズ社)、pp.251-266、1989年11月。
- 182(C) 大見忠弘、「将来のLSI技術と超伝導」、第5回応用物理学会・高温超伝導研究会、OHP集、((社)応用物理学会)、pp.31-32、1989年12月。